

絶縁膜のダメージ回復方法

技術の内容

半導体は、基板の上に様々な性質の膜を設ける成膜工程や、その膜の改質や不要部分の除去などの処理工程が繰り返されることで、製造される。この成膜や処理を行う手法の一つに、高いエネルギーを有するプラズマを用いる手法がある。しかしながら、プラズマはエネルギーが高く、必要以上に基板上の膜が損傷してしまう。
本技術は、この損傷した絶縁膜をドライプロセスにより、回復させる方法やその回復剤に関する技術である。

製品イメージ

本ダメージ回復剤は、プラズマ処理による層間絶縁膜の損傷を回復することができる。

製品のお客 イメージ

LSIなどの半導体製造において、プラズマ処理による層間絶縁膜のダメージ修復や腐食進行の防止が求められる半導体メーカーが対象。

実施許諾対象 業イメージ

半導体メーカー全般

各技術の詳細

1 [絶縁膜のダメージ回復方法](#)

出願番号	公開番号	登録番号
特願2008-512134	WO2007/123151	第5178511号

2 [絶縁膜のダメージ回復方法および回復剤](#)

出願番号	公開番号	登録番号
特願2007-271201	特開2009-099839	第5132244号

3 [絶縁膜のダメージ回復処理方法](#)

出願番号	公開番号	登録番号
特願2007-333106	特開2009-158610	第5173396号

出願番号	公開番号	登録番号
特願2010-030495	特開2011-166084	第5530744号